PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-180360

(43)Date of publication of application: 12.07.1996

(51)Int.CI.

(21)Application number: 06-317951

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

21.12.1994

(72)Inventor: NAKAMURA ATSUSHI

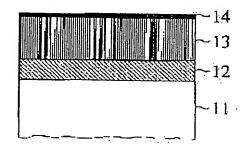
FUTAMOTO MASAAKI HIRAYAMA YOSHIYUKI TAKAYAMA TAKANOBU

(54) PERPENDICULAR MAGNETIC RECORDING MEDIUM AND MAGNETIC RECORDER

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a medium excellent in crystal orienting property and having high perpendicular magnetic anisotropy by forming an under film with a Co-Ru alloy.

CONSTITUTION: A Co-Ru alloy forms a solid soln. over the entire compsn. range at ordinary temp. and the crystal structure is a hexagonal close-packed structure. An under film 12 of the Co-Ru alloy is formed on a nonmagnetic substrate 11 such as a glass substrate or an NiP coated Al alloy substrate. In the film 12, (0001) faces become parallel to the substrate and c-axes are liable to orient perpendicularly. A perpendicularly magnetized film 13 of a Co-based alloy and a protective film 14 are then formed on the film 12 to obtain the objective perpendicular magnetic recording medium. The proper concn. of Ru is ≥40at.% because a compsn. having ≥40at.% concn. of Ru gives ≤0° C Curie temp.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

15.03.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3345199

[Date of registration]

30.08.2002

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-180360

(43)公開日 平成8年(1996)7月12日

(51) Int.Cl.4

說別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G11B 5/66

審査請求 未請求 請求項の数8 OL (全 7 頁)

(21)出願番号	特顧平6-317951	(71)出願人	000005108
(22)出顧日	平成6年(1994)12月21日		株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台四丁目 6 番地
•		(72)発明者	中村教
		4	東京都国分寺市東恋ケ窟1丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内
		(72)発明者	
			東京都国分寺市東郊ケ嶺1丁目280番地
		(20) Fr m2 +c	株式会社日立製作所中央研究所内
		(72)発明者	平山(義幸
			東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地
			株式会社日立製作所中央研究所内
		(74)代理人	弁理士 小川 勝男
			最終質に続く

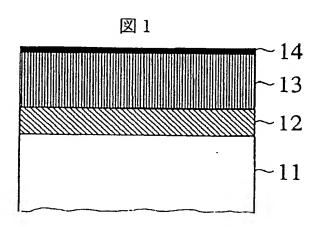
(54) 【発明の名称】 垂直磁気記録媒体及び磁気記録装置

(57)【要約】

【目的】垂直磁気異方性の大きな垂直磁気記録媒体を提供する。

【構成】非磁性基板11上に、CoとRuの合金からなる下地膜12, Co合金磁性膜13, 保護膜14を形成する。

【効果】C o 合金磁性膜の、 c 軸垂直配向性及び垂直磁 気異方性が向上し、高密度記録に適した垂直磁気記録媒 体を提供できる。



【特許請求の範囲】

【請求項】】非磁性基板と、前記非磁性基板上に形成さ れた下地膜と、前記下地膜上に形成されたCoを主成分 とする合金からなる垂直磁化膜と、前記垂直磁化膜上に 形成された保護膜とからなる垂直磁気記録媒体におい て、前記下地膜がC o と R u の合金からなることを特徴 とする垂直磁気記録媒体。

(請求項2)非磁性基板と、前記非磁性基板上に形成さ れた第一の下地膜と、前記第一の下地膜上に形成された 第二の下地膜と、前記第二の下地膜上に形成されたC o 10 を主成分とする合金の垂直磁化膜と,前記垂直磁化膜上 に形成された保護膜とからなる垂直磁気記録媒体におい て、前記第一の下地膜がTiまたはRuのいずれかから なり、前記第二の下地膜がCoとRuの合金からなると とを特徴とする垂直磁気記録媒体。

【請求項3】請求項2において、CoとRuの合金から なる前記下地膜が、Ruの濃度の異なる二層の膜からな り、前記垂直磁化膜の直下に位置する層のRu濃度が、 その直下に位置する層のRu濃度よりも低い垂直磁気記 绿煤体.

【請求項4】請求項2に記載の垂直磁気記録媒体におけ る、前記CoとRuの合金からなる下地膜において、R uの濃度が、前記非磁性基板に近い側から前記垂直磁化 膜側に向かって、連続的に低下している垂直磁気記録媒

【請求項5】請求項1から4のいずれかに記載の垂直磁 気記録媒体における、前記CoとRuの合金からなる下 地膜において、R u の濃度が、40a t %R u 以上であ る垂直磁気記録媒体。

【請求項6】請求項1、2、3または4において、前記 30 各下地膜の優先配向方位と、前記垂直磁化膜の優先配向 方位が、ともに〔000〕〕である垂直磁気記録媒体。 【請求項7】請求項1.2.3または4において、前記

非磁性基板の表面に微細な起伏を設けた垂直磁気記録媒

【請求項8】請求項1.2.3.4,5.6または7に 記載の垂直磁気記録媒体。前記垂直磁気記録媒体を保持 するための保持具、前記垂直磁気記録媒体に情報を記 録,再生するための磁気へッド,前記磁気へッドと前記 垂直磁気記録媒体の相対位置を移動させるための移動手 40 段、及びこれら各部を制御するための制御手段を有する 磁気記録装置。

【発明の詳細な説明】

(0001)

【産業上の利用分野】本発明は、高密度磁気記録に適す る磁性膜を備えた垂直磁気記録媒体及びそれを用いた磁 気記録装置に関する。

[0002]

【従来の技術】情報化社会の発展を背景に、大量の情報

への要求はますます髙まっている。より多くの情報をコ ンパクトに記録するために、従来から用いられている面 内磁気記録方式に代わって、さらに記録密度を向上でき る新たな記録方式として、垂直磁気記録方式が注目を集 めてきた。

【0003】垂直磁気記録は、記録媒体の表面に対して 垂直方向に形成した磁化を記録単位とする記録方式で、 磁化反転部分で反磁界の影響が小さくなるため、高密度 記録に適していると考えられる。これはアイイーイーイ ー トランザクションズ オン マグネティクス (IEEE Transactions on Magnetics), MAG-13 (1977) 1 272頁の論文に記述されている。この垂直磁気記録に 用いる記録媒体は、媒体表面に垂直な方向に磁化容易軸 を持ち、かつ大きな磁気異方性を持つ必要がある。との ため、基板上に垂直磁化膜を形成した薄膜媒体の研究開 発が行われてきた。

【0004】垂直磁気記録媒体の記録膜には、磁気異方 性の大きいCo合金を用いることが、従来から検討され てきた。CoCr合金等のCo合金は、六方最密充填構 20 造を持ち、その c 軸を磁化容易軸とする一軸磁気異方性 を示す。ガラスなどの非晶質基板の表面に、С o 合金の 薄膜を形成すると、原子の最稠密面である(0001)面 が基板面に平行になりやすく、[0001]配向した多 結晶薄膜が得られる。との膜は、垂直磁気異方性を示す が、垂直磁気記録媒体として用いるには、さらに大きな 磁気異方性を持たせることが必要であった。

【0005】そとで、基板上に下地膜を設けて、С0合 金磁性膜のc軸配向性を向上させる試みがなされてき た。Ti等の六方最密充填構造を持つ薄膜は、[000 1]配向しやすいため、これを下地膜として用い、Co 合金磁性膜の配向性を改善できることが報告されてい る。Ti下地膜を用いた垂直磁気記録媒体に関しては、 IEEE Transactions on Magnetics, MAG - 19(19)83)1644頁に記載の論文に記述されている。

【0006】ところが、このようなTi下地膜上に形成 したCo合金磁性膜のc軸の分散の大きさも、十分小さ いとはいえなかった。この原因は、TiとCo合金の格 子定数の差が15%と大きいため、Co合金の初期成長 時に配向性が乱れるためであると考えられる。そこで、 Co合金磁性膜のc軸配向性をさらに向上させるための

新たな下地膜の開発が望まれていた。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、従来 の下地膜上に形成したCo合金膜に比べて、さらに結晶 配向性に優れ、垂直磁気異方性の大きな、垂直磁気記録 媒体を提供すること、及びそれを用いた磁気記録装置を 提供することにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明の垂直磁気記録媒 を蓄積し、髙速に入出力することのできる磁気記録装置 50 体は、図1に示すように、非磁性基板11と、基板上に

形成された下地膜12と、下地膜上に形成されたCoを 主成分とする合金の垂直磁化膜 13と、垂直磁化膜上に 形成された保護膜 14とからなる垂直磁気記録媒体であ って、下地膜の材料がCoとRuの合金であることを特 徴とする。

【0009】本発明の垂直磁気記録媒体の第二の特徴 は、図2に示すように、非磁性基板21と、基板上に形 成された第一の下地膜22と、第一の下地膜上に形成さ れた第二の下地膜23と、第二の下地膜上に形成された Coを主成分とする合金の垂直磁化膜24と,垂直磁化 10 膜上に形成された保護膜25とからなる垂直磁気記録媒 体であって、第一の下地膜がTi またはRu のいずれか からなり、第二の下地膜がCoとRuの合金からなるこ とにある。

【0010】本発明の第二の構成の垂直磁気記録媒体で は、(1) CoとRuの合金からなる下地膜が、Ruの **濃度の異なる二層の膜からなり、垂直磁化膜の直下に位** 置する層のRu濃度が、この層の直下に位置する層のR u 濃度よりも小さいこと、(2)CoとRuの合金から なる下地膜で、Ruの濃度が、基板に近い側から垂直磁 20 化膜側に向かって、連続的に低下していること、のいず れかを満足する構成としてもよい。

【0011】本発明の第一、第二の構成の垂直磁気記録 媒体では、CoとRuの合金からなる下地膜は、Ruの 濃度が40at%Ru以上であることに特徴がある。

【0012】また本発明の第一、第二の構成の垂直磁気 記録媒体では、垂直磁化膜13及び24と、下地膜1 2. 22、及び23がいずれも [0001] 優先方位配 向をしているととに特徴がある。

【0013】さらに本発明の第一、第二の構成の垂直磁 30 気記録媒体では、基板11及び21の表面に微細な起伏 を設けた構成としてもよい。

【0014】本発明の磁気記録装置は、上記で説明した 第一,第二の構成による垂直磁気記録媒体,垂直磁気記 録媒体を保持するための保持具,垂直磁気記録媒体に情 報を記録、再生するための磁気ヘッド、磁気ヘッドと垂 直磁気記録媒体の相対位置を移動させるための移動手 段、及びこれら各部を制御するための制御手段から構成 される。

[0015]

【作用】上記の構成に用いるCoRu合金は、常温で全 組成範囲にわたって固溶体をつくることが知られてい る。結晶構造はCo及びRuと同じく六方最密充填構造 である。ガラス基板やNiPをコーティングしたAl合 金基板のような非晶質の表面を持つ基板上にこの合金の 薄膜を形成すると、(0001)面が基板に平行にな り、c軸が垂直配向しやすい。cのため、垂直磁気記録 媒体の記録膜として用いるCo合金磁性膜のc軸垂直配 向性を向上させるための下地膜として用いることができ る。Ruの濃度が40at%以上の組成域では、キュリ 50 aとした。この組成のCo合金磁性膜のa軸の長さは

ー温度が0℃以下になるため、この合金は強磁性を示さ なくなる。非磁性の下地膜として用いる場合、Ruの濃 度が40at%Ru以上の範囲で用いるのが適切であ

【0016】CoRu合金の格子定数は、合金の組成に 比例して連続的に変化する。Co及びRuのa軸の格子 定数はそれぞれ0.251nm、0.270nmである。 Co-40at%Ruの格子定数は0.259 nmであ る。したがって、Co-40at%Ruの合金を下地膜 に用いれば、Co合金磁性膜(a軸の格子定数が約0. 25 nm)との格子定数の差は、СоRu合金を基準に して-3%と小さくなる。したがって、この合金を下地 膜として用いると、Co合金の初期成長時の配向の乱れ を防止し、c軸垂直配向性の高い垂直磁化膜を作製する ことができる。

【0017】Ru及びTiは、c軸垂直配向しやすい が、Co合金磁性膜とのa軸の格子定数の差は、Ruを 下地膜に用いる場合は、-7%、Tiを用いる場合は、 - I 5%となり、CoRu合金の場合に比べていずれも 大きい。そこでTiあるいはRuの下地膜を形成した 後、その表面にCoRu合金下地膜を形成することによ り、格子定数差を緩和し、Co合金の格子定数に近い格 子定数を持つ下地膜を作製することができる。

【0018】さらに、CoRu合金下地膜を、Ru濃度 の異なる二層の膜からなる構成とし、TiあるいはRu の下地膜上にRu濃度の高い層を形成し、その表面にR u 濃度の低い層を形成することで、効果的に格子定数差 を緩和するととができる。また、CoRu合金下地膜の Ru濃度を、基板に近い側から垂直磁化膜側に向かっ て、連続的に低下させることによっても、格子定数差を **栂和することができる。**

【0019】このように、Co合金磁性膜のa軸の格子 定数に近い格子定数を持つCoRu合金を、下地膜に用 いることにより、Co合金磁性膜のc軸垂直配向性を髙 め、従来よりも髙密度記録に適した垂直磁気記録媒体を 提供できる。

[0020]

【実施例】

<実施例1>直径2.5 インチのガラス基板を用い、図 3に示すような断面構造を持つ磁気記録媒体を、DCマ グネトロンスパッタリング法によって作製した。基板3 lの両面に、CoRu合金下地膜32、32′, Co合 金磁性膜33,33′,カーボン保護膜34,34′を との順字で形成する。

【0021】成膜には、アルゴンガスを用い、ガスの圧 力0.7 Pa,基板温度260℃,成膜速度每分50n mの条件で形成した。下地膜の形成に用いるターゲット の組成はCo-40at%Ru, 磁性膜の形成に用いる ターゲットの組成はCo-15at%Cr-5at%T

0.251 nmであった。 各膜の膜厚は、 CoRu合金 下地膜が50nm. Co合金磁性膜が100nm. カー ボン保護膜が10nmとした。上記の膜形成はすべて同 一の真空槽内で真空を破ることなく連続して行った。 【0022】作製した試料の結晶配向をX線回折によっ て、磁気特性を試料振動型磁力計 (VSM)を用いてそ れぞれ測定した。X線回折では、CoRu合金下地膜及 びCo合金磁性膜のOOO2回折ピークが観測され、こ の膜が〔0001〕配向していることがわかった。Со

合金磁性膜のX線0002回折ピークのロッキング曲線*10

* を測定したところ、本実施例の磁気記録媒体は、下地膜 を用いずに全く同様の条件で作製した磁気記録媒体と比 較して、ロッキング曲線の半値幅が減少しており、Co 合金磁性膜の[0001]配向が改善されていた。膜面 垂直方向の保強力は38%(4200e)向上した。 【0023】さらに下地膜にCo-50at%Ru合 金.Co-75at%Ru合金を用いた場合にも、改善 効果が認められた。これらの結果を表しに示す。 [0024]

【表1】

下地膜	a 軸の長さ (nm)	X 線ロッキング 曲線の半値幅(度)	
Co-40at%Ru	0.259	2,8	1520
Co-50at%Ru	0.261	3,1	1490
Co-75at%Ru	0.265	3.1	1470
なし (比較例)		8.5	1100

【0025】〈実施例2〉直径1.8 インチのNiPを 20※真空を破ることなく連続して行った。 コーティングしたA 1 合金基板を用い、図4に示すよう な断面構造を持つ磁気記録媒体を、DCマグネトロンス パッタリング法によって作製した。基板41の両面に、 Ruからなる第一の下地膜42、42′、CoRu合金 からなる第二の下地膜43.43′.Co合金磁性膜4 4,44′,カーボン保護膜45,45′をこの順序で 形成する。

【0026】成膜には、アルゴンガスを用い、ガスの圧 力0.7 Pa, 基板温度260℃, 成膜速度每分50n mの条件で形成した。CoRu合金下地膜の形成に用い るターゲットの組成はCo-40at%Ru, 磁性膜の 形成に用いるターゲットの組成はCo-12at%Cr -10at%Ptとした。この組成のCo合金磁性膜の a軸の長さは0.255 nmであった。各膜の膜厚は、 Ru下地膜が30nm、CoRu合金下地膜が50n m. Co合金磁性膜が100nm. カーボン保護膜が1 0 n mとした。上記の膜形成はすべて同一の真空槽内で※

【0027】作製した試料の結晶配向をX線回折によっ て、磁気特性を試料振動型磁力計(VSM)を用いてそ れぞれ測定した。X線回折では、Ru下地膜、CoRu 合金下地膜及びCo合金磁性膜のOOO2回折ピークが 観測され、との膜が[0001]配向しているととがわ かった。Co合金磁性膜のX線0002回折ピークのロ ッキング曲線を測定したととろ、本実施例の磁気記録媒 体は、CoRu合金下地膜を用いずに全く同様の条件で作 製した磁気記録媒体と比較して、ロッキング曲線の半値 幅が減少しており、Co合金磁性膜の[0001]配向 が改善されていた。膜面垂直方向の保磁力は13%(1 900e) 向上した。

【0028】さらにRu下地膜に代えて、Ti下地膜を 用いた場合にも、改善効果が認められた。これらの結果 を表2に示す。

[0029]

【表2】

下地膜	X 線 ロッキング 曲線の半値幅(度)	
CoRu/Ru	2.5	1700
Ru(比較例)	3,6	1510
CoRu/Ti	2.7	1650
Ti (比較例)	3.5	1580

【0030】とのような垂直磁気記録媒体を用いて、図 5 に模式的に示すような垂直磁気記録方式による磁気記 録装置を作製した。垂直磁気記録媒体51は、モータに より回転する保持具により保持され、それぞれの各磁性 膜に対応して情報の書き込み. 読み出しのための磁気へ 50 インターフェース制御回路57が設けられている。Co

ッド52が配置されている。この磁気ヘッド52の磁気 記録媒体51に対する位置をアクチュエータ53とボイ スコイルモータ54により移動させる。さらにこれらを 制御するために記録再生回路55.位置決め回路56.

Ru下地膜を用いた垂直磁気記録媒体で、高密度記録が 可能であることを確かめた。

【0031】〈実施例3〉直径1.8 インチのガラス基 板を用い、図4に示すような断面構造を持つ磁気記録媒 体を、イオンビームスパッタリング法によって作製し た。基板41の両面に、Ruからなる第一の下地膜4 2. 42′. CoRu合金からなる第二の下地膜43. 43′. C o合金磁性膜44.44′.カーボン保護膜 45, 45′をこの順序で形成する。

【0032】成膜には、アルゴンガスを用い、基板温度 10 260℃, 成膜速度毎分50 n m の条件で形成した。 C o R u 合金下地膜の形成には、二つのイオン銃を用い、 CoターゲットとRuターゲットを独立にスパッタリン グして同時に成膜した。Ruの成膜速度を制御すること によって、膜中のRuの張度を、膜厚方向に連続的に変 化させた。磁性膜の形成に用いるターゲットの組成はC o-12at%Cr-10at%Ptとした。この組成 のCo合金磁性膜のa軸の長さは0.255nmであっ た。各膜の膜厚は、Ru下地膜が30nm。CoRu合 ーボン保護膜が10nmとした。上記の膜形成はすべて 同一の真空槽内で真空を破ることなく連続して行った。 【0033】作製した試料の結晶配向をX線回折で、膜 厚方向の組成の変化をオージェ電子分光法により、磁気 特性を試料振動型磁力計(VSM)を用いてそれぞれ測 定した。X線回折では、Ru下地膜、CoRu合金下地 膜及びCo合金磁性膜の0002回折ビークが観測され、と の膜が〔0001〕配向していることがわかった。Co 合金磁性膜のX線0002回折ピークのロッキング曲線 を測定したところ、本実施例の磁気記録媒体は、CoR 30 u合金下地膜を用いずに全く同様の条件で作製した磁気 記録媒体と比較して、ロッキング曲線の半値幅が35% 滅少しており、Co合金磁性膜の[0001]配向が改 善されていた。CoRu合金下地膜の膜厚方向の組成分 布は、膜表面に向かってRu濃度がなだらかに減少して おり、Ru下地膜との界面付近でCo-72at%R u, Co合金磁性膜との界面付近でCo-46at%R

【0034】この組成のCoRu合金のa軸の長さを見 積もると、Ru下地膜との界面付近で0.265nm. Co合金磁性膜との界面付近で0.260nmである。 との値から見積もった、格子のミスフィット量は、Ru 下地膜とCoRu合金下地膜の界面で-4.0%。Co Ru合金下地膜とCo合金磁性膜の界面で-1.8%で ある。膜面垂直方向の保磁力も21%(3100e)向 上した。

uであった。

【0035】〈実施例4〉直径1.8 インチのガラス基 板を用い、図6に示すような断面構造を持つ磁気記録媒 体を、DCマグネトロンスパッタリング法によって作製 した。基板61の両面に、Ti下地膜62.62',C

o - 7 0 a t % R u 合金下地膜 6 3 , 6 3′, C o - 4 Oat%Ru合金下地膜64,64′, Co合金磁性膜 65,65′,カーボン保護膜66,66′をこの順序 で形成する。成膜に先立ち、基板の表面をアルゴンイオ ンによってスパッタリングし、平均深さ約2nmの筬細 な起伏を形成した。成膜には、アルゴンガスを用い、基 板温度250℃,成膜速度毎分50mmの条件で形成し

【0036】磁性膜の形成に用いるターゲットの組成は Co-15at%Cr-5at%Taとした。この組成の Co合金磁性膜のa軸の長さは0.251 nmであっ た。各膜の膜厚は、Ti下地膜が30nm、Co-70 a t %R u 合金下地膜が25 n m,C o - 40 a t %R u合金下地膜が25nm.Co合金磁性膜が100n m,カーボン保護膜が10nmとした。上記の膜形成は すべて同一の真空槽内で真空を破るととなく連続して行 otc.

【0037】作製した試料の結晶配向をX線回折で、磁 気特性を試料振動型磁力計(VSM)を用いてそれぞれ測 金下地膜が50nm, Co合金磁性膜が100nm, カ 20 定した。X線回折では、Ti下地膜, CoRu合金下地 膜及びC o 合金磁性膜の0002回折ピークが観測さ れ、この膜が[0001]配向していることがわかっ

> 【0038】Co合金磁性膜のX線0002回折ピーク のロッキング曲線を測定したところ、本実施例の磁気記 録媒体は、CoRu合金下地膜を用いずに全く同様の条 件で作製した磁気記録媒体と比較して、ロッキング曲線 の半値幅が27%減少しており、Co合金磁性膜の[0 001]配向が改善されていた。との場合の格子のミス フィット量は、Ti下地膜とCo-70at%Ru合金 下地膜の界面で-10%,Co-70at%Ru合金下 地膜とCo-40at%Ru合金下地膜の界面で-2. 2 %.Co-40at%Ru合金下地膜とCo合金礎 性膜の界面で-2.9 %である。膜面垂直方向の保磁力 も、CoRu合金下地膜を用いずに全く同様の条件で作 製した磁気記録媒体と比較して8%(1300e)向上

【0039】この垂直磁気記録媒体を用いて、図5に模 式的に示すような垂直磁気記録方式による磁気記録装置 を作製した。基板表面の微細な起伏の効果で、磁気ヘッ ドが媒体表面に固着することなく、安定した記録再生が 行えた。

[0040]

【発明の効果】本発明のように、CoRu合金を下地膜 に用いることにより、Co合金磁性膜のc軸垂直配向性 を高め、従来よりも高密度記録に適した高性能の垂直磁 気記録媒体を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第一の実施例の垂直磁気記録媒体の断 50 面構造の説明図。

חח

【図2】本発明の第二の実施例の垂直磁気記録媒体の断面構造の説明図。

(図3)本発明の第一の実施例の垂直磁気記録媒体の断面構造の説明図。

【図4】本発明の第二の実施例の垂直磁気記録媒体の断面構造の説明図。

【図1】

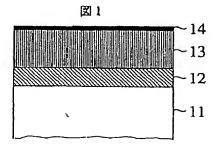
*【図5】本発明の磁気記録装置のブロック図。

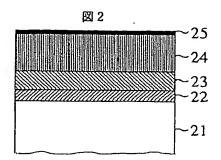
【図6】本発明の第三の実施例の垂直磁気記録媒体の断面構造の説明図。

【符号の説明】

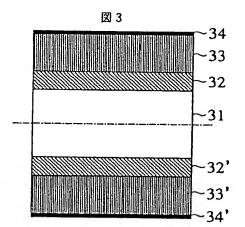
11…非磁性基板、12…CoRu合金下地膜、13… Co合金磁性膜、14…保護膜。

【図2】

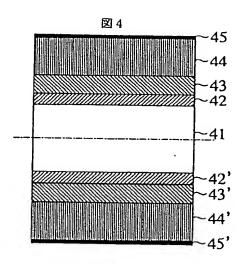


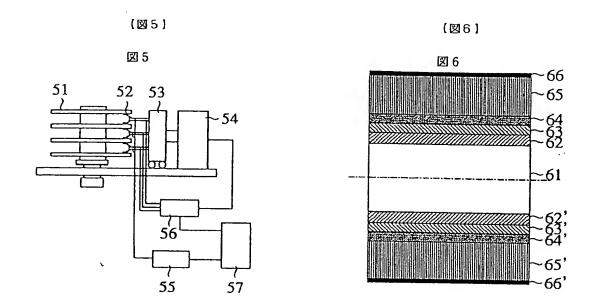


【図3】



(図4)





フロントページの続き

(72)発明者 髙山 孝信 東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第6部門第4区分【発行日】平成13年4月6日(2001.4.6)

【公開番号】特開平8-180360

【公開日】平成8年7月12日(1996.7.12)

【年通号数】公開特許公報8-1804

【出願番号】特願平6-317951

【国際特許分類第7版】

G11B 5/66

(FI)

G118 5/66

【手続補正書】

【提出日】平成12年3月15日(2000.3.1 5)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】非磁性基板と、前記非磁性基板上に形成されたCoとRuを含む合金からなる下地膜と、前記下地膜上に形成されたCoを主成分とする合金からなる垂直磁化膜と、前記垂直磁化膜上に形成された保護膜とから構成されることを特徴とする垂直磁気記録媒体。

【請求項2】非磁性基板と、前記非磁性基板上に形成されたTiまたはRuのいずれかを含む第一の下地膜と、前記第一の下地膜上に形成されたCoとRuを含む合金からなる第二の下地膜と、前記第二の下地膜上に形成されたCoを主成分とする合金の垂直磁化膜と、前記垂直磁化膜上に形成された保護膜とから構成されることを特徴とする垂直磁気記録媒体。

【請求項3】前記第二の下地膜が、R u の濃度の異なる 二層の膜からなり、前記垂直磁化膜側の膜のR u 濃度 が、前記基板側の膜のRu 濃度よりも低いことを特徴と する請求項2記載の垂直磁気記録媒体。

【請求項4】前記第二の下地膜において、Ruの濃度が、前記基板側から前記垂直磁化膜側に向かって連続的 に低下していることを特徴とする請求項2記載の垂直磁 気記録媒体。

【請求項5】前記下地膜において、Ruの濃度が40at%以上であることを特徴とする請求項1記載の垂直磁気記録媒体。

【請求項6】前記第二の下地膜において、Ruの濃度が40at%以上であるととを特徴とする請求項2乃至4記載の垂直磁気記録媒体。

【請求項7】前記下地膜の優先配向方位と、前記垂直磁化膜の優先配向方位が、ともに [0001] であることを特徴とする請求項1乃至6記載の垂直磁気記録媒体。【請求項8】請求項1.2.3.4.5.6 または7に記載の垂直磁気記録媒体、前記垂直磁気記録媒体を保持するための保持具、前記垂直磁気記録媒体に情報を記録、再生するための磁気ヘッド、前記磁気ヘッドと前記垂直磁気記録媒体の相対位置を移動させるための移動手段、及びこれら各部を制御するための制御手段を有する磁気記録装置。